

关键指标

频率范围：DC~20GHz

插入损耗：0.25dB

衰减范围：0/0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5dB

输出输出驻波：1.2/1.2

芯片尺寸：0.74mm×0.65mm×0.1mm

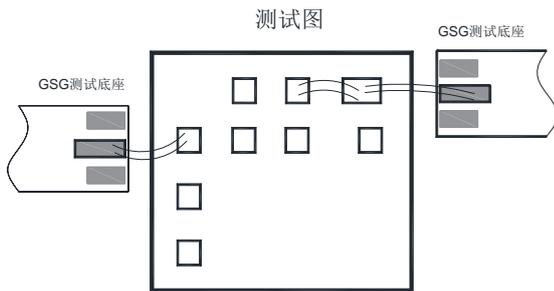
产品简介

HG136SA 是一款 DC~20GHz 固定衰减器芯片，输入输出驻波 1.2。

电性能 (TA=25℃, 键合测试)

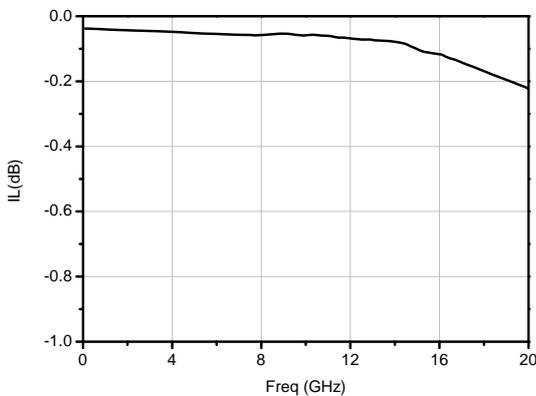
| 指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|----------|-------|------|-----|
| 频率(GHz) | DC~20 | | |
| 插入损耗(dB) | - | 0.25 | - |
| 衰减精度(dB) | - | ±0.1 | - |
| 输入驻波 | - | 1.2 | - |
| 输出驻波 | - | 1.2 | - |

测试示意图 (芯片采用 GSG 测试座, 键合金丝测试)

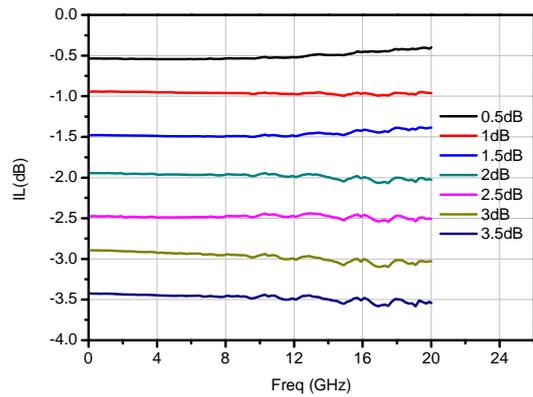


典型测试曲线

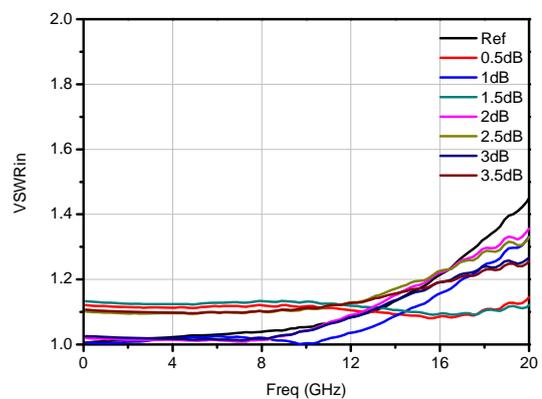
参考态插入损耗



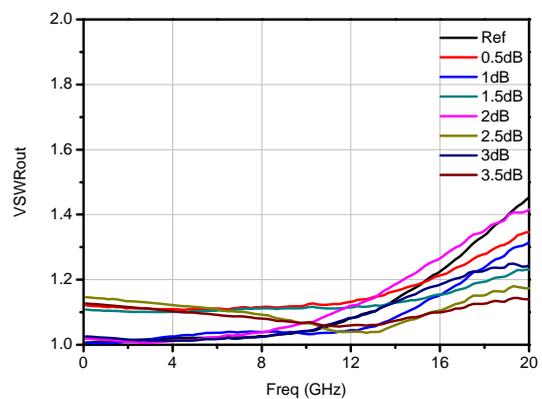
插入损耗



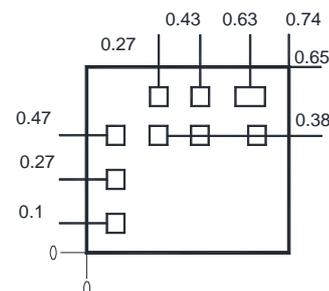
输入驻波



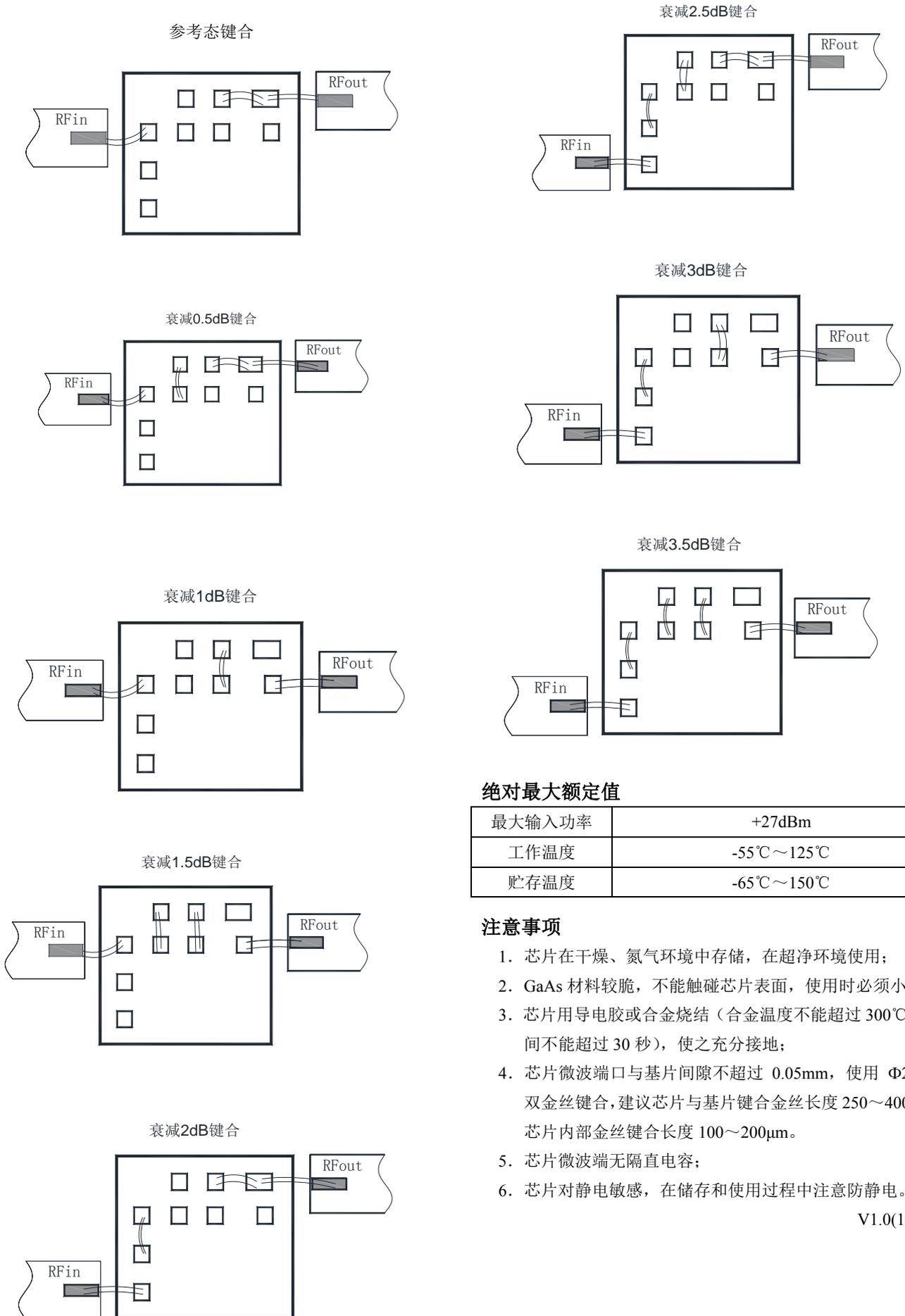
输出驻波



外形和端口尺寸 (mm)



装配示意图



绝对最大额定值

| | |
|--------|-----------|
| 最大输入功率 | +27dBm |
| 工作温度 | -55℃~125℃ |
| 贮存温度 | -65℃~150℃ |

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议芯片与基片键合金丝长度 250~400 μm ，芯片内部金丝键合长度 100~200 μm 。
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。

V1.0(16/22)